

InGaAs фотодиод 1654 нм, 1000 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIT3-1000A

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая чувствительность
- Спектральная чувствительность 900–1740 нм
- Низкий темновой ток

ПРИМЕНЕНИЕ

- Детектирование в ближнем ИК-диапазоне, газовые сенсоры
- Мониторинг
- Измерительные приборы

Электрооптические характеристики (T=25 °C, Vcc=3.3 В)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Чувствительность	R	@1654nm,VR=0V	0.9	1	-	А/Вт
Темновой ток	Id	VR=-5V	-	0.5	2.5	нА
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм
Активная область	φ	-	995	1000	1005	мкм
Емкость	C	VR=-5V	-	55	65	пФ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	Top	-40	85	°C
Температура хранения	Tstg	-40	125	°C
Прямой ток	IF	-	10	мА

Назначение выводов и габаритный чертёж

